

## 参数表

**HVP-20** 高压二极管采用高可靠性的台面结构及扩散工艺，环氧树脂真空灌注密闭封装。

**HVP-20** High voltage diode adopts high reliable mesa structure and diffusion craftwork, epoxy resin molded in a compact structure.

### ▼ 产品特点 Feature

- ❖ 雪崩电压击穿保护特性 **Avalanche Characteristic**
- ❖ 优异的抗浪涌电流冲击特性 **Excellent surge current resistance**
- ❖ 高速开关响应特性 **High speed switch response characteristics**
- ❖ 采用新型环氧树脂真空封装技术，表面具有抗腐蚀性  
**Epoxy resin molded in vacuum, have anticorrosion in the surface**
- ❖ 工作结温 -50°C—+150°C **Tj:50°C—+150°C**
- ❖ 特殊耐高温性能芯片，可承受严酷恶劣的使用条件  
**Special high temperature resistant chip that can withstand harsh working**

conditions

### ▼ 产品 2D 图示

#### Graphical Representation

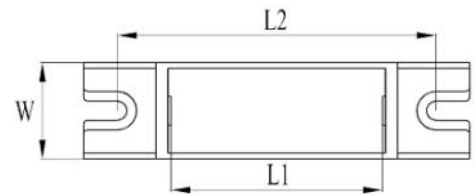
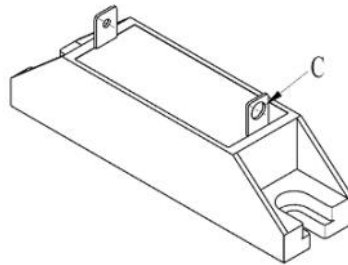


	参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions	数值 Rating
Absolute Maximum Ratings 极限值 (绝对最大值)	反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	KV	Ta=25°C I <sub>R</sub> =2.0μA	20
	反向工作峰值电压) Peak Working Reverse Voltage	$V_{RWM}$	KV	Ta=25°C I <sub>R</sub> =2.0μA	20
	正向平均电流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	正弦半波 50Hz, 电阻负载, T <sub>break</sub> =50°C ( 50Hz Half-sine Wave , Resistance load @T <sub>break</sub> =50°C )	1.0
	反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	nS		--
	正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	A	正弦半波持续时间 0.01S 50Hz 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz	50
	工作环境温度 Operating Ambient Temperature	T <sub>a</sub>	°C		-40 ~ +150
	存储温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	°C		-40 ~ +120
Electrical Characteristics 电特性	正向峰值电压 Forward Peak Voltage	$V_{FM}$	V	@ Ta=25°C I <sub>F</sub> =1A	≥28
	反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM1}$	μA	@ Ta=25°C V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	5.0
		$I_{RRM2}$	μA	@ Ta=100°C V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	50.0

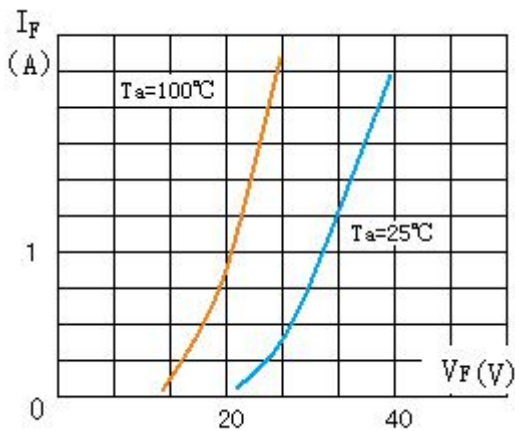
▼外形尺寸图示 Outline Drawings (单位：毫米 mm)

图号/尺寸	Fig②
长(L)	80
宽(W)	20
高(H)	20
极距 (L1)	45
定位孔距(L2)	70
插片	8*15

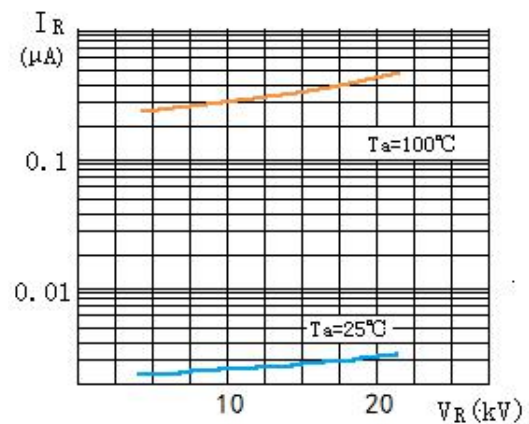
Fig②



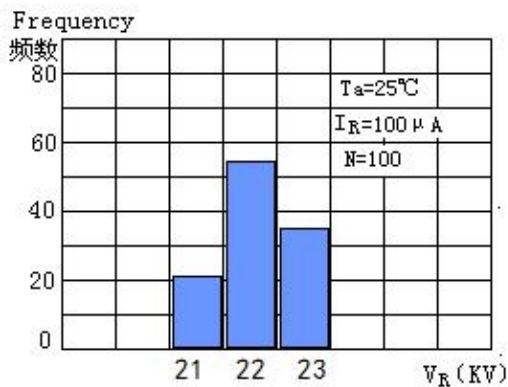
▼ 特性曲线图 Characteristic Curve



正向特性曲线 ( HVP-20 )  
Forward Characteristics



反向特性曲线 ( HVP-20 )  
Reverse Characteristics



反向雪崩电压分布 ( HVP-20 )  
Avalanche Breakdown Voltage Distribution